

عنوان مقاله:

بررسی خاصیت پیزورزیستیویته پلی سیلیکون با تاکید بر رشد دانه ها و پارامتر های فرایند ساخت

محل انتشار:

کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

زهرا رستمی بیستونی - دانش آموخته کارشناسی ارشد - گروه برق ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمانشاه ، کرمانشاه ، ایران

حمید شرافت وزیری - عضو هیات علمی ، گروه برق ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمانشاه ، کرمانشاه ، ایران

خلاصه مقاله:

ویژگی های الکتریکی لایه های سیلیکون پلی کریستالی به ساختار دانه ها بستگی دارد. این مقاله توصیف جامع از رشد دانه پلی سیلیکون در طیف گسترده ایی از دوپینگ و شرایط پردازش را نشان می دهد ، دوپینگ پلی سیلیکون با B ، As ، p می باشد این نتایج نشان میدهد که دوپینگ نوع n باعث افزایش رشد دانه می شود ، در حالیکه دوپینگ نوع P دارای اثر ناچیزی است ، تاثیر رشد دانه را بر روی خاصیت پیزورزیستیویته نیز مشاهده می شود.

کلمات کلیدی:

پیزورزیستیو، دوپینگ، ناخالصی ، نفوذ ، رشد دانه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/810375>

